Рентгенографические исследования термохромного фазового перехода в кристалле $[NH_2(C_2H_5)_2]_2CuCl_4$

© А.У. Шелег, Е.М. Зуб, А.Я. Ячковский

Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников Национальной академии наук Белоруссии, 220072 Минск, Белоруссия

E-mail: sheleg@ifttp.bas-net.by

(Поступила в Редакцию 6 марта 2006 г.)

Проведены рентгенографические исследования параметров элементарной ячейки кристалла $[NH_2(C_2H_5)_2]_2CuCl_4$ и рассчитаны коэффициенты теплового расширения для основных кристаллографических направлений в области температур $100-330\,\mathrm{K}$. Изучено поведение интенсивностей дифракционных рефлексов от кристалллографических плоскостей (100), (010) и (001) при переходе через температуру термохромного фазового перехода. Получены экспериментальные данные, подтверждающие наличие фазового перехода первого рода в кристалле $[NH_2(C_2H_5)_2]_2CuCl_4$ при $T\approx 324\,\mathrm{K}$.

Работа выполнена в рамках проекта Ф04-005, финансируемого Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований.

PACS: 61.50.Ks, 61.10.Nz, 65.40.De

1. Введение

Кристаллы диэтиламинтетрахлоркупрата $[NH_2(C_2H_5)_2]_2CuCl_4$ $((ДЭА)_2CuCl_4)$ относятся семейству A_2BX_4 , у многих представителей которого наблюдается последовательность температурных фазовых переходов ($\Phi\Pi$). Кристаллы (ДЭА)₂CuCl₄ относятся к органико-неорганическим кристаллам с водородными связями между молекулярными катионами и металл-галогенными комплексами [1]. Кристаллическая структура такого типа кристаллов определяется в основном балансом водородных связей в элементарной ячейке, которые под влиянием внешних воздействий (температура, давление, облучение) трансформируются, что приводит к ее изменению. В кристалле (ДЭА)₂CuCl₄ под воздействием температуры при $T \approx 323 \, \mathrm{K}$ наблюдается термохромный ФП первого рода, в результате которого при росте температуры у кристалла происходит не только изменение цвета с зеленого на желтый, но и трансформация его кристаллической структуры из моноклинной с пространственной группой $P2_1/n$ в моноклинную с пространственной группой $P2_1/c$ с изменением параметров элементарной ячейки [2]. Параметры элементарной ячейки низкотемпературной фазы при комнатной температуре равны $a = 7.362 \,\text{Å}$, $b=15.023\,\mathrm{\AA},\ c=45.193\,\mathrm{\AA},\ \beta=89.94^\circ$ и Z=12, а для высокотемпературной они составляют $a = 25.055 \,\text{Å},$ $b = 10.531 \,\text{AA}, \ c = 13.455 \,\text{Å}, \ \beta = 100.06^{\circ} \ \text{и} \ Z = 8 \ [2].$ Природа термохромного ФП в кристалле (ДЭА)₂CuCl₄ исследовалась оптическим [1] и рентгенографическим [2] методами; было показано, что причиной изменения структуры и цвета этого кристалла является изменение плоскоквадратной геометрии координационного окружения иона Cu²⁺ на тетраэдрическую. Изменение геометрии координационного окружения обусловлено большой чувствительностью водородных связей к внешним воздействиям, в данном случае к температуре.

Целью настоящей работы является рентгенографическое исследование температурных зависимостей интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов, параметров элементарной ячейки и коэффициентов теплового расширения низкотемпературной фазы кристалла $(\mbox{ДЭA})_2 \mbox{CuCl}_4$ в широкой области температур (и особенно в окрестности термохромного фазового перехода).

2. Методика эксперимента

Кристаллы (ДЭА) $_2$ СuCl $_4$ выращивались из водного раствора солей CuCl $_2\cdot 2H_2$ O и (С $_2H_5$) $_2$ NH $_2$ Cl, взятых в стехиометрическом соотношении, методом медленного испарения растворителя при комнатной температуре. В результате в течение трех-четырех недель вырастали кристаллы размером $\sim 10\times 6\times 3$ mm.

Рентгенографические измерения параметров элементарной ячейки проводились на дифрактометре TUR-M62 с использованием $\operatorname{Cu} K_{\alpha}$ -излучения и низкотемпературной рентгеновской камеры. Измерения проводились в интервале температур 100-330 К. В качестве образцов использовались монокристаллические пластинки размером $\sim 5 \times 4 \times 2$ mm, вырезанные из выращенных кристаллов. Отражающими плоскостями служили естественная грань роста (010), которая выходила на поверхность образцов, и плоскость скола (100). Плоскость (001) выводилась на поверхность образцов рентгенографическим методом с точностью 5-7'. Помещенный в держатель образец перед каждой рентгеносъемкой термостатировался в течение 10-15 min при заданной температуре. Методом непрерывного сканирования по схеме $\theta - 2\theta$ проводилась запись профилей интенсивностей рефлексов на перфоленту через каждые $1-2\,\mathrm{K}$ со скоростью счетчика $0.25\,\mathrm{deg/min}$. Дифракционные углы определялись по центру тяжести профилей рефлексов 700, $0.14.0\,\mathrm{u}$ $0.0.30\,\mathrm{c}$ точностью 0.2-0.4'. Температура образца задавалась блоком регулировки, выполненным на основе регулятора температуры. Контроль температуры проводился с помощью медьконстантановой термопары. Эта система позволяла задавать и поддерживать температуру в измеряемой области с точностью $\pm 0.1\,\mathrm{K}.$

Результаты исследования и их обсуждение

Значения параметров элементарной ячейки кристалла $(ДЭА)_2$ CuCl₄, определенные нами при комнатной температуре, равны $a=7.362\pm0.005\,\text{Å},\ b=15.025\pm0.004\,\text{Å},\ c=45.152\pm0.006\,\text{Å},\ что хорошо согласуется с результатами работы [2].$

На рис. 1–3 приведены температурные зависимости параметров элементарной ячейки $a(T),\ b(T)$ и c(T) и значения коэффициента теплового расширения (КТР) $\alpha_a(T),\ \alpha_b(T)$ и $\alpha_c(T)$ кристалла [NH $_2(C_2H_5)]_2\cdot CuCl_4$. Как видно из рисунков, параметры a,b и c с ростом температуры плавно увеличиваются. Кривая b(T) не является монотонной, и при приближении к температуре $\Phi\Pi\ T\approx 324\ {\rm K}$ происходит увеличение параметра b. На кривой c(T) в области температур $\sim 265-280\ {\rm K}$ наблюдается аномалия в виде плато. По экспериментальным температурным зависимостям параметров элементарной ячейки $a(T),\ b(T)$ и c(T) определены соответствующие КТР вдоль основных кристаллографических направлений [100], [010] и [001] в исследованном интервале температур.

Для определения значений КТР экспериментальные кривые $a(T),\,b(T)$ и c(T) были аппроксимированы наиболее подходящими полиномами вида $L=A+\sum\limits_i^n B_i T^i.$ Аппроксимационные кривые разбивались на температурные отрезки длиной $2-4\,\mathrm{K},\,$ на которых расчет КТР проводился согласно формуле $\alpha_K=\Delta L/(L\Delta T),\,$ где L=a,b,c в середине отрезка $\Delta T,\,$ для которого

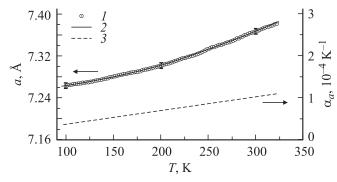


Рис. 1. Температурная зависимость параметра a элементарной ячейки кристалла (ДЭА) $_2$ CuCl $_4$ (I — эксперимент, 2 — аппроксимация) и КТР α_a (3).

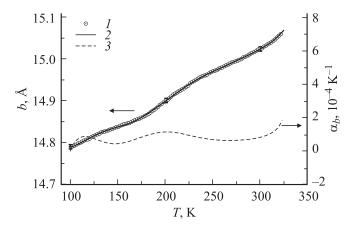


Рис. 2. Температурная зависимость параметра b элементарной ячейки кристалла (ДЭА) $_2$ CuCl $_4$ и КТР α_b . Обозначение кривых то же, что и на рис. 1.

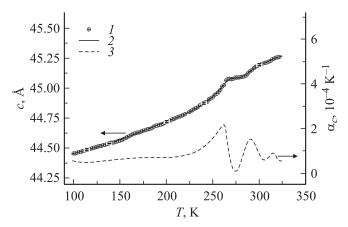


Рис. 3. Температурная зависимость параметра c элементарной ячейки кристалла (ДЭА) $_2$ CuCl $_4$ и КТР α_c . Обозначение кривых то же, что и на рис. 1.

определялся КТР, ΔL — изменение параметра на этом отрезке.

На рис. 1-3 (штриховые линии) приведены температурные зависимости значений КТР $\alpha_a(T)$, $\alpha_b(T)$ и $\alpha_c(T)$ вдоль основных кристаллографических осей. Из рисунков видно, что значения КТР α_a во всем исследуемом интервале температур с ростом температуры увеличиваются по линейному закону. Значения α_h в области температур $100-300\,\mathrm{K}$ и α_c в интервале температур 100-250 К практически не изменяются с ростом температуры и только вблизи температуры ФП происходит резкое увеличение КТР α_b , а на кривой $\alpha_c(T)$ при $T \approx 275 \, \mathrm{K}$ наблюдается аномалия в виде минимума. Возможно, эта аномалия обусловлена разупорядочением молекулярных катионов в кристаллической структуре (ДЭА)₂CuCl₄. Из полученных данных видно, что в кристалле (ДЭА), СиСІ, анизотропия теплового расширения отсутствует.

На рис. 4 приведены дифрактограммы кристалла $(ДЭA)_2CuCl_4$, записанные при различных значениях тем-

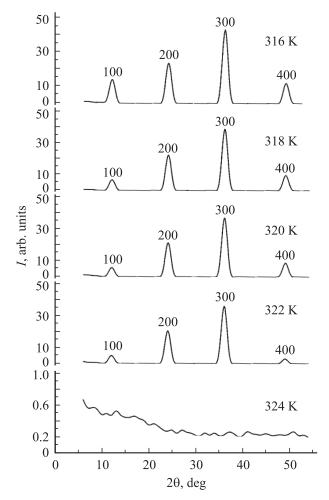


Рис. 4. Дифрактограммы, записанные от плоскости (100), при различных температурах кристалла (ДЭА) $_2$ CuCl $_4$.

пературы образца. Запись проводилась от плоскости скола (100). При температурах $T_1=316~{\rm K},\ T_2=318~{\rm K},\ T_3=320~{\rm K},\ T_4=322~{\rm K}$ на дифрактограммах наблюдаются дифракционные рефлексы, характерные для низкотемпературной фазы исследуемого кристалла. С ростом температуры интенсивности всех рефлексов незначительно уменьшаются, и только при $T_4=324~{\rm K}$ они исчезают. Запись дифрактограммы при $T=324~{\rm K}$ проводилась в режиме максимальной чувствительности измерителя скорости счета импульсов в отличие от дифрактограмм, записанных при более низких температурах.

На рис. 5 приведены температурные зависимости интенсивностей дифракционных рефлексов 300, 050 и 0.0.15 кристалла (ДЭА) $_2$ СиСl $_4$ в интервале $\sim 316-324\,\mathrm{K}$ в режиме нагревание-охлаждение. Из этого рисунка видно, что с ростом температуры интенсивности всех рефлексов незначительно уменьшаются, при $T=322\,\mathrm{K}$ происходит резкое падение интенсивностей, а при $T=324\,\mathrm{K}$ они равны нулю. Нагревание образца кристалла (ДЭА) $_2$ СиСl $_4$ до $T=332\,\mathrm{K}$ не приводит к появлению дифракционных рефлексов высокотемпературной фазы. При последующем охлаждении начиная с этой

температуры рефлексы, соответствующие низкотемпературной фазе, снова появляются только при $T>320\,\mathrm{K}$ и по мере уменьшения температуры их интенсивность растет. Однако следует заметить, что величины интенсивностей всех рефлексов в режиме охлаждения значительно меньше, чем при тех же температурах в режиме нагревания. Таким образом, наблюдается гистерезис интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов в области температуры ФП. Наличие температурного гистерезиса подтверждает существование ФП первого рода в этом кристалле. Из рис. 5 также видно, что данный ФП является обратимым, т.е. при охлаждении кристалла из области выше температуры ФП низкотемпературная фаза восстанавливается.

Следует отметить, что разупорядочение кристаллической структуры, которое происходит при переходе кристалла в высокотемпературную фазу, при последующем охлаждении полностью не исчезает, поскольку интенсивности дифракционных линий не восстанавливаются до первоначальных значений (рис. 5). Отсутствие

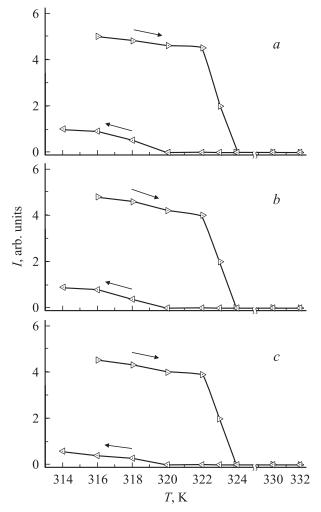


Рис. 5. Температурные зависимости интенсивностей дифракционных рефлексов 300 (a), 050 (b) и 0.0.15 (c) в режиме охлаждения и нагревания в области термохромного $\Phi\Pi$.

дифракционной картины при нагревании образца от 234 до 332 К свидетельствует об отсутствии кристаллической высокотемпературной фазы выше температуры ФП. Таким образом, в процессе нагревания низкотемпературной фазы невозможно получить высокотемпературную кристаллическую фазу. Это утверждение согласуется с результатами работы [2], где показано, что низкотемпературная фаза, нагретая выше температуры ФП, теряет кристалличность. Из рис. 5 следует, что температура ФП равна $T = 324 \, \mathrm{K}$, что хорошо согласуется с результатами работы [3], где при исследовании теплоемкости данного кристалла установлено, что температура ФП этого кристалла $T = 323.7 \, \mathrm{K}$. Для получения высокотемпературной фазы авторы работы [2] разработали специальную методику, которая состоит в том, чтобы получать высокотемпературную фазу не из раствора, а из расплава (ДЭА) $_2$ СиС $_4$ при температуре T > 323 K, т. е. выше температуры термохромного $\Phi\Pi$.

4. Заключение

Рентгенографическим методом подтверждено наличие $\Phi\Pi$ первого рода при $T=324\,\mathrm{K}$ в кристалле $(\mbox{ДЭA})_2\mathrm{CuCl}_4$.

Показано, что в области $\Phi\Pi$ в этом кристалле наблюдается гистерезис интенсивностей брэгговских рефлексов, а сам переход является обратимым.

Установлено, что при нагревании низкотемпературной фазы кристалла $(ДЭА)_2CuCl_4$ выше температуры $\Phi\Pi$ исчезает ее кристалличность, т.е. получить высокотемпературную фазу таким способом невозможно.

Список литературы

- [1] В.Б. Капустянык, Ю.М. Корчак. ЖПС 67, 759 (2000).
- [2] D.R. Bloomguist, M.R. Pressprich, R.D. Willet. J. Am. Chem. Soc. 110, 7391 (1988).
- [3] А.У. Шелег, Т.И. Декола, Н.П. Теханович. ФТТ **47**, 2050 (2005).